

Examen de Electrónica 2
30/07/2011

Resolver cada problema en hojas separadas.

Duración de la prueba: 3 horas 30 minutos.

La prueba es sin material.

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.

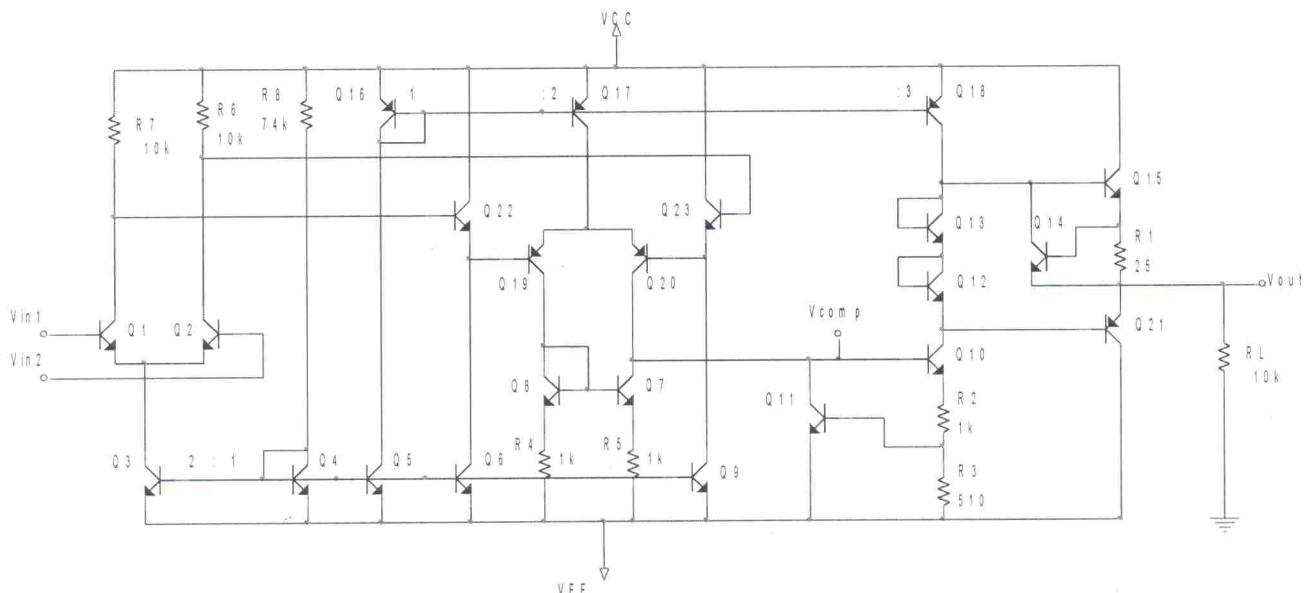
Problema 1 (38 ptos):

El circuito de la figura es un amplificador operacional con compensación externa.

- Determine cual es la entrada no inversora.
- Determine la corriente de polarización de los transistores Q3, Q6, Q9, Q17 y Q18.
- Determine qué transistores implementan la protección contra cortocircuitos a la salida del amplificador, cómo la implementan y qué valores máximos de corriente puede entregar y tomar a la salida el amplificador.
- Determine el rango de entrada en modo común del amplificador.
- Determine la ganancia a bajas frecuencias del amplificador.
- La capacidad de compensación externa se conecta entre el pin Vcomp y el pin Vout. Determine el valor de la capacidad necesaria para tener un $f_T=10\text{MHz}$.

Datos:

- $V_{CC}=-V_{EE}=10\text{ V}$
- $V_{BE}=|V_{EB}|=0.7\text{ V}$, $V_{CESAT}=0.3\text{ V}$
- Tensión de Early: $V_A=\infty$, excepto para Q18 donde $V_A=25\text{V}$
- $\beta=200$ excepto en Q15 y Q21 donde $\beta=50$



Problema 2 (38 ptos):

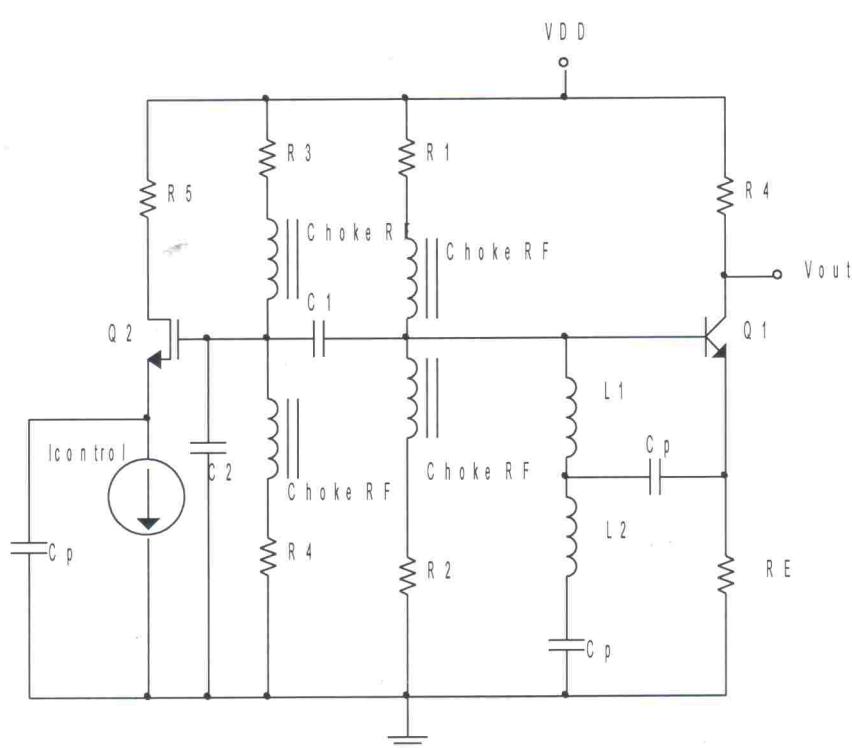
El circuito de la figura es un oscilador del tipo Hartley. En el cual para realizar un ajuste fino en la frecuencia se agrega un condensador variable implementado por Q2.

- Calcular frecuencia y condición de oscilación. Exprese el resultado en forma literal suponiendo que el condensador que agrega Q2 es C_{Q2} .
- Si la polarización de Q2 es tal que el mismo se encuentra en la zona de saturación calcular el valor de la frecuencia de oscilación cuando $I_{control} = 2\text{mA}$.
- Calcular el rango de variación de la frecuencia de oscilación si $I_{control}$ varía entre 0.5mA y 3.5mA .

Datos: El β del transistor se podrá considerar muy grande, los condensadores C_p se podrán considerar infinitos. Se supondrá que los inductores Choke RF presentan una impedancia infinita para toda frecuencia > 0 .

Para Q2 : $C_{ox} = 4e-3 \text{ pF}/\mu\text{m}^2$, $\mu_n = 48.4e9 \mu\text{m}^2/\text{V.s}$, $W = 200\mu\text{m}$, $L = 0.5\mu\text{m}$, $C_{gs_overlap} = 3.0e-4 \text{ pF}/\mu\text{m}$, $R_5 = 2\text{k}\Omega$.

$C_1 = 15\text{pF}$, $C_2 = 5\text{pF}$, $L_1 = L_2 = 50\mu\text{H}$.



Pregunta (24ptos):

Se tiene una etapa de salida clase B implementada con un par complementario TIP 41 / TIP 42, (cuyos datos se muestran en la hoja adjunta); alimentado con +/- 15V y cargado con una resistencia de 4Ω a tierra.

Calcular:

1. La máxima potencia que se puede entregar a la carga.
2. La máxima potencia que debe disipar cada transistor para todos los valores de amplitud de pico a la salida y la eficiencia del circuito cuando se está disipando esta potencia.
3. Si los transistores están sin disipador y la máxima temperatura ambiente es de 45°C , cuál es la máxima potencia que el circuito puede entregar a la carga sin dañar los transistores y a qué temperatura de juntura corresponde esta potencia.
4. Si los transistores tienen un disipador con una resistencia térmica de 4°C/W , en contacto con el encapsulado del transistor con una resistencia térmica de 0.5°C/W , cuál es la máxima potencia que el circuito puede entregar a la carga sin dañar los transistores.

Considerar en todo el problema despreciables las tensiones base-emisor y de saturación.

Complementary Silicon Plastic Power Transistors

... designed for use in general purpose amplifier and switching applications.

- Collector-Emitter Saturation Voltage —
 $V_{CE(sat)} = 1.5 \text{ Vdc (Max) } @ I_C = 6.0 \text{ Adc}$
- Collector-Emitter Sustaining Voltage —
 $V_{CEO(sus)} = 60 \text{ Vdc (Min) } — \text{TIP41A, TIP42A}$
 $= 80 \text{ Vdc (Min) } — \text{TIP41B, TIP42B}$
 $= 100 \text{ Vdc (Min) } — \text{TIP41C, TIP42C}$
- High Current Gain — Bandwidth Product
 $f_T = 3.0 \text{ MHz (Min) } @ I_C = 500 \text{ mAdc}$
- Compact TO-220 AB Package

*MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	TIP41A TIP42A	TIP41B TIP42B	TIP41C TIP42C	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	80	100	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CB}	60	80	100	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EB}		5.0		Vdc
Collector Current — Continuous Peak	I_C		6 10		Adc
Base Current	I_B		2.0		Adc
Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D		65 0.52		Watts W/ $^\circ\text{C}$
Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D		2.0 0.016		Watts W/ $^\circ\text{C}$
Unclamped Inductive Load Energy (1)	E		62.5		mJ
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}		-65 to +150		$^\circ\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Internal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	62.5	$^\circ\text{C/W}$
Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{\theta JC}$	1.92	$^\circ\text{C/W}$

1) $I_C = 2.5 \text{ A}, L = 20 \text{ mH}, \text{P.R.F.} = 10 \text{ Hz}, V_{CC} = 10 \text{ V}, R_{BE} = 100 \Omega$

*referred devices are Motorola recommended choices for future use and best overall value.

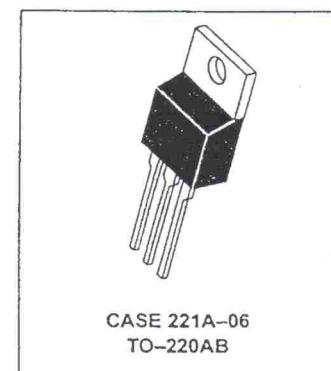
REV 1

Motorola, Inc. 1995
Motorola Bipolar Power Transistor Device Data

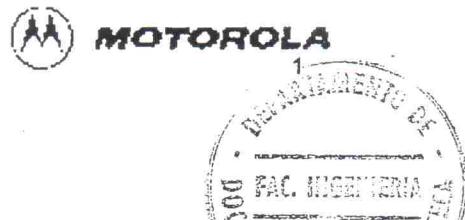
NPN TIP41A
TIP41B*
TIP41C* PNP
TIP42A
TIP42B*
TIP42C*

*Motorola Preferred Device

6 AMPERE
POWER TRANSISTORS
COMPLEMENTARY
SILICON
60-80-100 VOLTS
65 WATTS



CASE 221A-06
TO-220AB



Examen Electrónica 2

30/07/2011

Problema 1

(a)

$$V_{in} \uparrow \Rightarrow I_{C_3} \uparrow \Rightarrow N_{b_{22}} \downarrow \Rightarrow N_{b_{19}} \downarrow$$

$$\Rightarrow I_{C_{19}} \uparrow \Rightarrow N_{b_{15}} \downarrow \Rightarrow N_{b_{23}} \uparrow \Rightarrow N_o \uparrow$$

$\rightarrow V_{in}$ es la entrada NO-INVERSORA

(b)

$$I_{C_4} = \frac{V_{CC} - V_{SS} - V_{BE}}{R_S} \Rightarrow I_{C_4} = 260 \mu A$$

$$\Rightarrow I_{C_3} = 2 \times I_{C_4} = 520 \mu A$$

$$I_{C_6} = I_{C_9} = I_{C_m} = 260 \mu A$$

$$I_{C_{12}} = 2 I_{C_6} = 520 \mu A$$

$$I_{C_{18}} = 3 I_{C_6} = 780 \mu A$$

(c) La protección la implementa los transistores $Q_{15} \rightarrow Q_{13}$

① Protección contra corriente SALIENTE:

Wanto I_L es tal que $I_L \times R_1 > V_{BE}$, Q_{15} se enciende \rightarrow Tom coníete de la base de Q_{15} indicando que I_L no pueda aumentar

② Protección contra corriente ENFRIANTE:

Wanto hay un pico de corriente al final, Q_{15} está apagado \rightarrow lo coníete por Q_{13} es

$$I_{C_D} = I_{C_{18}} + I_L / \beta_{21}$$

Papiror

→ want $\Gamma_{C3} \times R_3 > V_{BE}$ se evite de
que \rightarrow form conierto del nodo N_{B30}

→ $N_{B30} \rightarrow$ Nout $\uparrow \rightarrow$ por los Γ_{T21}

I_L (enfrente) no daña más

$$\rightarrow \begin{cases} I_L(\text{out})_{\max} = V_{BE}/R_3 = 28 \text{ mA} \\ I_L(n)_{\max} = (V_{BE}/R_3 - I_{C30}) \times \beta_{21} = 29,6 \text{ mA} \end{cases}$$

(d)

$$I_{CN}(n_f) = V_{EE} + V_{CESAT_3} + V_{BE1}$$

$$I_{CN}(inf) = -9 \text{ V}$$

$$I_{CN}(\text{sup}) = V_{CC} - \frac{R_2 I_{C3}}{2} - V_{CESAT_3} + V_{BE1}$$

$$= 10,7 - 2,6 \text{ V} - 0,3 \text{ V}$$

$$I_{CN}(\text{sup}) = +7,8 \text{ V}$$

$$(V_2 = 25 \text{ V})$$

$V_h = \infty \Rightarrow$ totas las $R_o = \infty$, excepto $R_{o22} = 32 \text{ k}\Omega$

1^a etapa

$$\frac{N_{o1}}{N_{in}} = g_{m1} \times (R_2 \parallel R_{V21e})$$

2^a etapa:

$$R_{V21e} = \Gamma_{T22} + (\beta + 1) \Gamma_{T19} \quad \begin{matrix} \text{(supone)} \\ \text{entradas} \\ \text{diferenciales} \end{matrix}$$

$$\frac{N_{o2}}{N_{o1}} = \frac{g_{m22} \Gamma_{T19}}{g_{m22} \Gamma_{T19} + 1} \times \underbrace{g_{m19} \times R_{V32e}}_{\text{seguir}} \quad \text{par. 4.4}$$

$$\Gamma_{T22} = \Gamma_{T19} = 20 \text{ m}\Omega$$

$$\Rightarrow R_{V21e} \approx (\beta + 1) \Gamma_{T19} = 4 \text{ m}\Omega$$

$$g_{m22} \times \Gamma_{T19} = \frac{I_{C22} \times BVF}{\sqrt{I_{C19}}} = \beta \Rightarrow g_{m22} \Gamma_{T19} \gg 1$$

$$\Rightarrow \frac{N_{o2}}{N_{o1}} = g_{m19} R_{V32e}$$

Parámetro

(e) (Signe)

$$3^{\text{h}} \text{ etape} : R_{V_{3e}} = \frac{(R_{T_0} + (\beta+1)(R_2 + R_3))}{\gamma_{T_0}} = 309 \text{ m}\Omega$$

$$R_{C_{10}} = \frac{\gamma_{T_0}}{\beta_2} R_2 \quad (\text{terme } \approx R_{V_{2e}} \text{ et } \text{multiplificateur de } V_{BE})$$

$32 \text{ n} \ll 500 \text{ n}$

$$\Rightarrow \frac{N_{out}}{N_{O2}} = \frac{\beta R_{C_{10}}}{R_{T_0} + (\beta+1)(R_2 + R_3)} \quad \begin{array}{l} \text{PREMIERES } I_{C_{10}} > 2,6 \mu\text{A} \\ \Rightarrow g_{m_{10}} R_2 \gg 1 \\ \Rightarrow N_{out} \approx N_{O2} \end{array}$$

$$\Rightarrow A_1 = \left| \frac{N_{O1}}{N_{O2}} \right| \approx g_{m_1} R_2 = 500 \text{ V/V} \quad (R_2 \ll R_{V_{2e}})$$

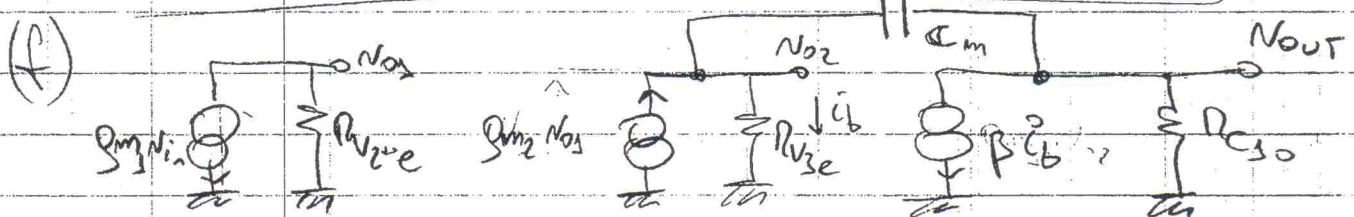
$\hookrightarrow g_{m_1} = 0,05 \text{ A/V}$

$$A_2 = \left| \frac{N_{O2}}{N_{O3}} \right| = g_{m_{10}} R_{V_{2e}} = 3090 \text{ V/V}$$

$\hookrightarrow g_{m_{10}} = 0,01 \text{ A/V}$

$$A_3 = \left| \frac{N_{out}}{N_{O2}} \right| = 19,4 \text{ V/V}$$

$$\Rightarrow |G_{DC}| \approx 6 \times 10^6 \text{ V/V} \approx 133,3 \text{ dB}$$



$$w_{polo son.} = \frac{1}{R_{V_{3e}} C_m \times A_3}$$

$$G_{DC} = g_{m_1} R_2 \times g_{m_{10}} R_{V_{2e}} > A_3$$

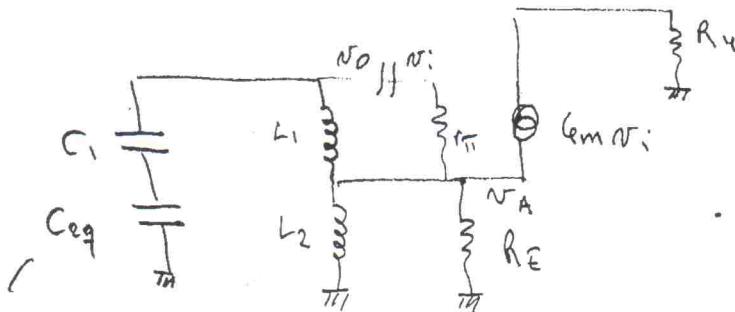
$$\Rightarrow C_m (f_T = 10 \text{ MHz}) = 15,9 \text{ nF}$$

$$w_T = \frac{g_{m_1} R_2 \times g_{m_{10}}}{C_m}$$

POLAROID

Problema 2:

a)



$$C_g = C_2 + C_{Q_2}$$

$$g_m N_i = \frac{N_A}{R_E} + \frac{N_A}{L_2 s} + \frac{N_A - N_0}{L_1 s}$$

$$\frac{N_A - N_0}{L_1 s} = \frac{N_0 \cdot C_1 \cdot C_{eq} s}{(C_1 + C_{eq})}$$

$$C_{\text{tot}} = \frac{C_1 \cdot C_{eq}}{C_1 + C_{eq}}$$

$$\frac{N_0}{N_i} = \frac{g_m R_E L_1 L_2 s}{L_1^2 L_2 C_{\text{tot}} s^3 + R_E L_1^2 C_{\text{tot}} s^2 + L_1 L_2 R_E (C_{\text{tot}} s^2 + L_1 L_2 s + R_E L_1)}$$

$$Im = 0 \Rightarrow -R_E L_1 ((L_1 + L_2) C_{\text{tot}} s^2 + 1) = 0$$

$$\Rightarrow w^2 = \frac{1}{(L_1 + L_2) C_{\text{tot}}} \Rightarrow w = \sqrt{\frac{1}{(L_1 + L_2) C_{\text{tot}}}}$$

$$\frac{g_m R_E L_1 L_2}{L_1^2 L_2 C_{\text{tot}} w^2 + L_1 L_2} = 1 \Rightarrow g_m R_E = \frac{L_2}{L_1 + L_2}$$

b)



$$C_{gs} = \frac{2}{3} \cdot w \cdot L \cdot C_{ox} + C_{gsox} \cdot w = 0,33 \mu F$$

$$C_{gd} = C_{gd} \cdot \alpha \times w = 0,06 \mu F$$

$$g_m R_L = \sqrt{2 \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{w}{L} \cdot I_D} \cdot R_L = 30$$

$$g_m R_L \cdot C_{gd} = 0,03 \text{ pF} \quad 36 = 1,08 \text{ pF}$$

$$C_{MOS} = 1,08 + 0,33 = 1,42 \text{ pF}$$

$$C_{eq} = 5 \text{ pF} + 1,42 = 6,42 \text{ pF}$$

$$C_{TOT} = 4,50 \text{ pF}$$

$$f = 47,1 \text{ MHz.}$$

c)

$$I_D = 0,5 \text{ mA} \Rightarrow g_m R_L = 17,6$$

$$\Rightarrow C_{MOS} = 0,88 \Rightarrow C_{eq} = 5,88 \text{ pF} \Rightarrow C_{TOT} = 4,5 \text{ pF}$$

$$\Rightarrow f = 48,7 \text{ kHz}$$

$$I_D = 3,5 \text{ mA} \Rightarrow g_m R_L = 46,6$$

$$\Rightarrow C_{MOS} = 1,73 \text{ pF}$$

$$\Rightarrow C_{eq} = 6,73 \text{ pF}$$

$$\Rightarrow C_{TOT} = 4,65 \text{ pF}$$

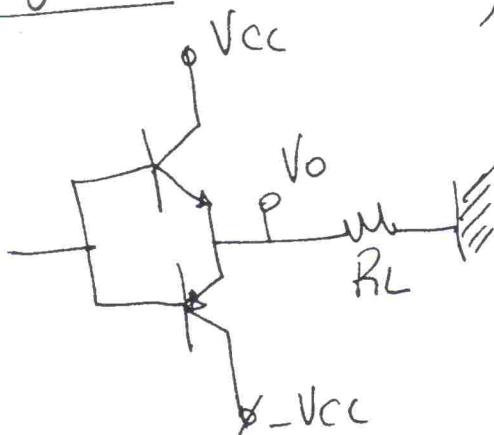
$$\Rightarrow f = 46,2 \text{ MHz.}$$

Electrónica 2

Pregunta 2:

$$2) \text{ Pmáx corfa} = \frac{V_{cc}^2}{2R_L} = 28W$$

$\hat{V}_o = V_{cc}$



$$2) \text{ Pmáx disipado por cada transistor} = \frac{\frac{1}{4}V_{cc}^2}{\pi^2 R_L} = 5.7W$$

que ocurre cuando $\hat{V}_o = \frac{2V_{cc}}{\pi}$
y el rendimiento es 50%.

$$3) \theta_{jA} = 62.5^\circ C/W$$

$T_j = 150^\circ C$	$T_A = 45^\circ C$
" "	" "

$$\text{Pmáx disipable sin disipar} = \frac{T_{j\max} - T_A}{\theta_{jA}} =$$

$$= 1.68W$$

$$P_{disipar} = \frac{\hat{V}_o}{\pi R_L} V_{cc} - \frac{1}{4} \frac{\hat{V}_o^2}{R_L} = 1.68W$$

$$\Rightarrow \hat{V}_o = 1.53V \Rightarrow P_L = 0.3W$$

$$T_j = 150^\circ C$$

$$4) \theta_{jA} = \theta_{jc} + \theta_{cs} + \theta_{sa} = 6.42^\circ C/W$$

$\theta_{jc} = 1.82$	$\theta_{cs} = 0.5$	$\theta_{sa} = 4$
----------------------	---------------------	-------------------

$$\Rightarrow \text{Pmáx disipable} = \frac{150 - 45}{6.42} = 16.35W$$

que es menor que lo calculado en 2) $\Rightarrow P_{máx} = 28W$ como en 2)